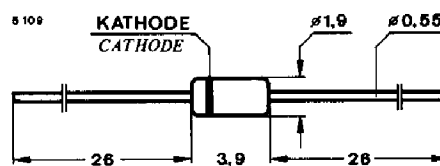


Silizium-Epitaxial-Planar-Diode Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Sehr Schnelle Schalter

Applications: Very fast switches

Abmessungen in mm
Dimensions in mm



Normgehäuse
Case
54 A 2 DIN 41 880
JEDEC DO 35
Gewicht · Weight
max. 0,15 g

Absolute Grenzdaten Absolute maximum ratings

Periodische Sperrspannung Repetitive peak reverse voltage	U_{RRM}	25	V
Sperrspannung Reverse voltage	U_R	20	V
Stoßdurchlaßstrom Surge forward current $t_p \leq 1 \mu s$	I_{FSM}	2	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom Repetitive peak forward current	I_{FRM}	225	mA
Durchlaßstrom Forward current	I_F	115	mA
Durchlaßstrom, Mittelwert Average forward current $U_R = 0$	I_{FAV}	75	mA
Verlustleistung Power dissipation $l = 4 \text{ mm}, t_L = 45^\circ\text{C}$ $t_L \leq 25^\circ\text{C}$	P_V	440	mW
	P_V	500	mW
Sperrschichttemperatur Junction temperature	t_j	200	$^\circ\text{C}$
Lagerungstemperaturbereich Storage temperature range	t_{stg}	-55...+200	$^\circ\text{C}$

BAY 93

Wärmewiderstand Thermal resistance

Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

$l = 4 \text{ mm}$, $t_L = \text{konstant}$
constant

R_{thJA}

350 °C/W

Kenngrößen Characteristics

$t_j = 25^\circ\text{C}$, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Durchlaßspannung
Forward voltage

$I_F = 10 \text{ mA}$

$U_F^*)$

1 V

Sperrstrom
Reverse current

$U_R = 10 \text{ V}$, $t_j = 150^\circ\text{C}$

$I_R^{**})$

100 μA

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

$I_R = 1 \mu\text{A}$

$U_{(BR)}^*)$

20

V

Diodenkapazität
Diode capacitance

$U_R = 0$, $f = 1 \text{ MHz}$, $U_{HF} = 50 \text{ mV}$

C_D

5 pF

Rückwärtserholzeit
Reverse recovery time

$I_F = I_R = 10 \text{ mA}$, $i_R = 1 \text{ mA}$

t_{rr}

15 ns

*) AQL = 0,65%

**) AQL = 2,5%